

MICROELETRÔNICA

LISTA DE EXERCÍCIOS – UNIDADE 1

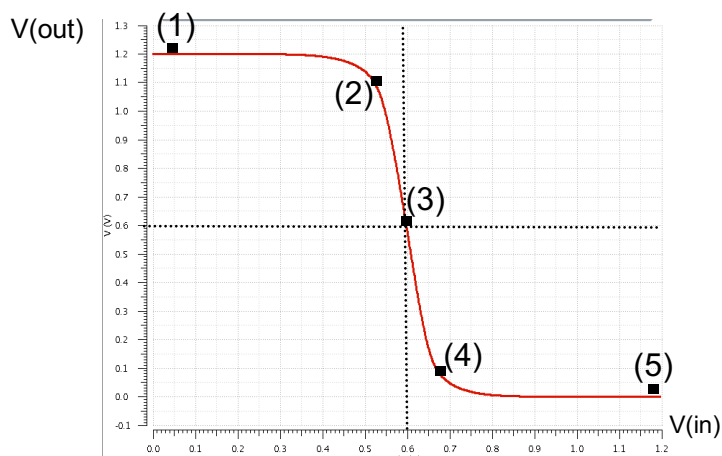
Fernando Gehm Moraes

20/ABRIL/2023

- 1) Explicar na tabela abaixo a influência dos principais parâmetros do transistor MOS na corrente I_{ds} (corrente dreno-source).

Parâmetro	Ação para aumentar o I_{ds} (duas respostas possíveis: aumentar ou diminuir)	Explicar a razão
W		
L		
Mobilidade		
Espessura óxido		

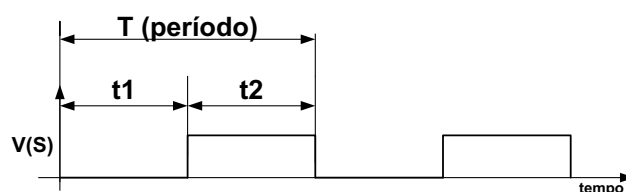
- 2) A figura abaixo ilustra a curva DC do inversor, para o caso que o dimensionamento W_p/W_n é equivalente ao fator de mobilidade μ_n/μ_p ($W_p/W_n = \mu_n/\mu_p$).



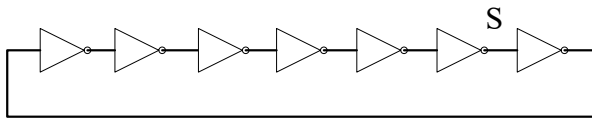
Ponto	NMOS	PMOS
1		
2		
3		
4		
5		

Pede-se:

- Qual o estado dos transistores N e P para cada um dos 5 pontos da curva, completando a tabela acima com as letras: **C**, **L**, **S** (cortado, linear (ou resistivo), saturado).
 - Como ficaria esta curva DC no caso do dimensionamento $W_p/W_n < \mu_n/\mu_p$? Justifique, desenhando a nova curva no mesmo gráfico acima.
- 3) Explique por que em células CMOS estáticas deve haver dualidade nas conexões (série em uma plano e paralelo no outro plano). Mostrar através de exemplos os problemas que podem ocorrer.
- 4) Oscilador em anel. Considere um oscilador em anel de 7 estágios, tendo o inversor $t_r=2,6$ / e $t_f=1,4$ ns. Determine t_1 , t_2 , período e frequência.

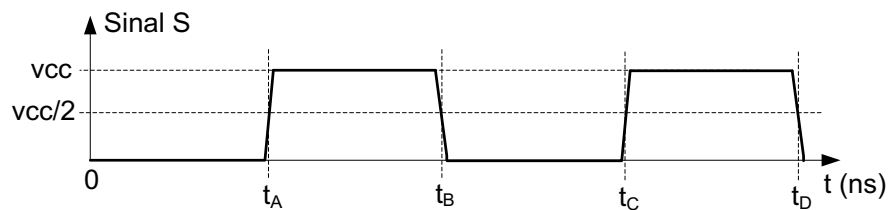


- 5) A figura abaixo ilustra um oscilador em anel.



Pede-se:

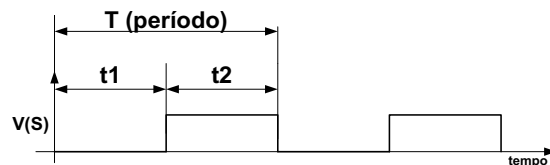
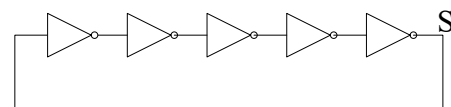
- (a) Dado que $t_r = 1.0$ ns (tempo de propagação de subida de um inversor) e $t_f = 0.5$ ns (tempo de propagação de descida de um inversor), qual o período (unidade: ns) e a frequência (unidade: MHz) resultante no nodo S?
- (b) A figura abaixo ilustra a saída do oscilador. Determine os tempos t_A , t_B , t_C , t_D , mostrando como eles foram obtidos. Como os tempos de subida e descida são diferentes, o duty cycle não é 50%.



- 6) Considere um oscilador em anel de 5 estágios, tendo o inversor $t_r = 3,5$ ns (tempo de propagação de subida de um inversor) e $t_f = 4,5$ ns (tempo de propagação de descida de um inversor).

Pede-se:

- a) Determine os tempos t_1 e t_2 (em ns) – explique o procedimento para obter os valores?
- b) Em função de t_1 e t_2 , determine T e diga qual a frequência de oscilação (em MHz).

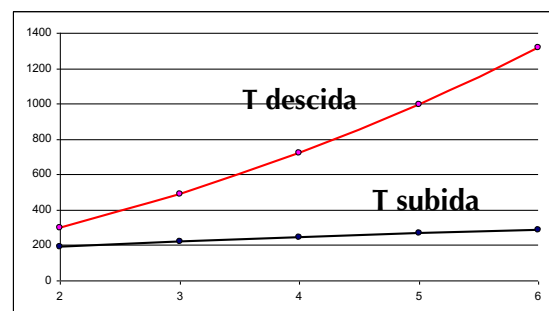


7) Portas NAND/NOR

- a. Considerar uma porta NAND com tamanho de transistores constantes. Trace em um mesmo gráfico os tempos de subida e descida em função do número de entradas (no eixo y o atraso da porta e no eixo x número de entradas da porta), supondo a variação de apenas uma entrada. Explique o comportamento apresentado.
- b. Repita o item anterior para a porta NOR, também com tamanho de transistores constantes.
- c. Explique o impacto da posição da entrada da porta lógica no atraso da mesma.

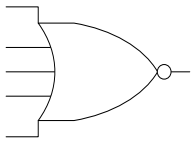
- 8) O gráfico abaixo apresenta no eixo y o atraso da porta lógica, e no eixo x o número de entradas variando de 2 a 6.

- a) A qual porta lógica corresponde o gráfico? Fazer um diagrama de transistores para 4 entradas.
- b) Explique o porquê do aumento do tempo de propagação de descida, e o motivo do tempo de subida ser praticamente constante.



PORTAS LÓGICAS COMPLEXAS

- 9) Devido à limitação do número de transistores em série, portas lógicas com mais de 4 transistores não são utilizadas, devido ao aumento da tensão de *threshold*. Considere a porta lógica abaixo, uma *nor* de 5 entradas.



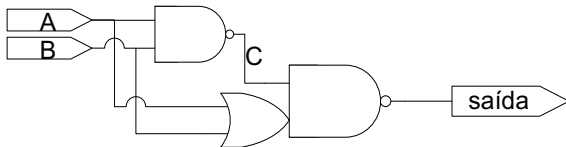
Utilizando os teoremas de De Morgan, descritos abaixo, desenhe um circuito lógico equivalente, utilizando portas *nands*, *nors* e inversor, com no máximo 3 entradas.

$$\text{not } (P \text{ and } Q) = (\text{not } P) \text{ or } (\text{not } Q)$$

$$\text{not } (P \text{ or } Q) = (\text{not } P) \text{ and } (\text{not } Q)$$

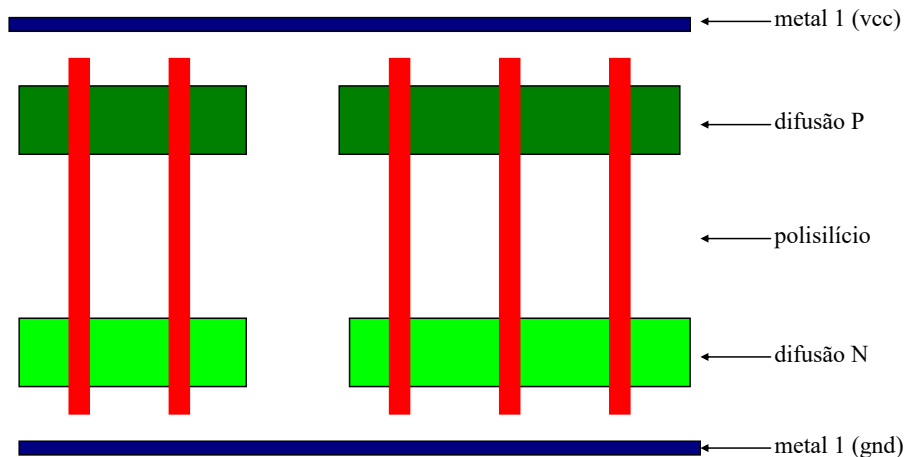
- 10) Implemente a seguinte função: $Y = (A+B)C + BD + ACD + AC + BCD + AD$ com no máximo 10 transistores. Logicamente, deve-se minimizar esta equação, e depois implementá-la via portas complexas. Faça os diagramas lógicos e elétrico da função minimizada. Dica: determine a função Y minimizada (será a porta complexa) e acrescente um inversor na saída.

- 11) Considere a circuito abaixo, composto de uma porta lógica *nand* e uma porta complexa:

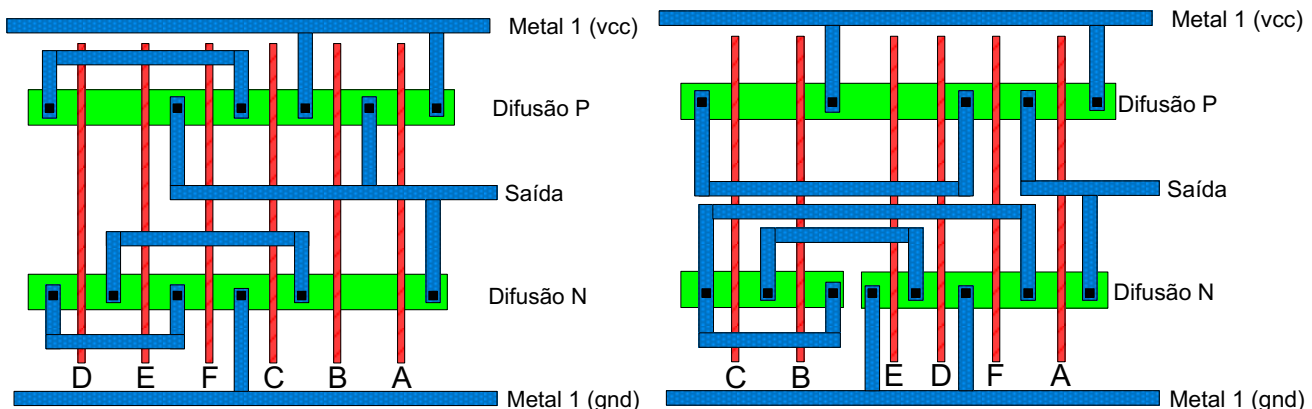


Pede-se:

- Diagrama de transistores
- Número de transistores
- Função lógica da porta (faça a tabela verdade e diga à qual função corresponde)
- Diagrama de *stick* do circuito. Para o diagrama *stick* utilize o layout abaixo para ponto de partida. Não há necessidade de quebras nas linhas de difusão para este exemplo.



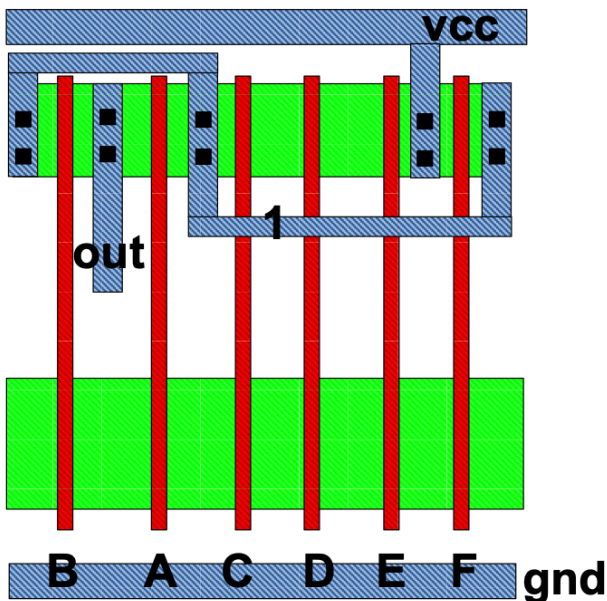
- 12) Considere os diagramas *stick* abaixo:



Para cada um deles determinar:

- Número de transistores total, número de transistores N, número de transistores P
- Diagrama de transistores
- Diagrama lógico
- Qual o número máximo de transistores há em série no plano N (conjunto de transistores N) e no plano P?
- Se esta mesma função fosse implementada com portas simples (*nand*, *nor*, *inversor*) quantos transistores seriam necessários? Justifique.

13) Considere o layout abaixo, com apenas os transistores P roteados.

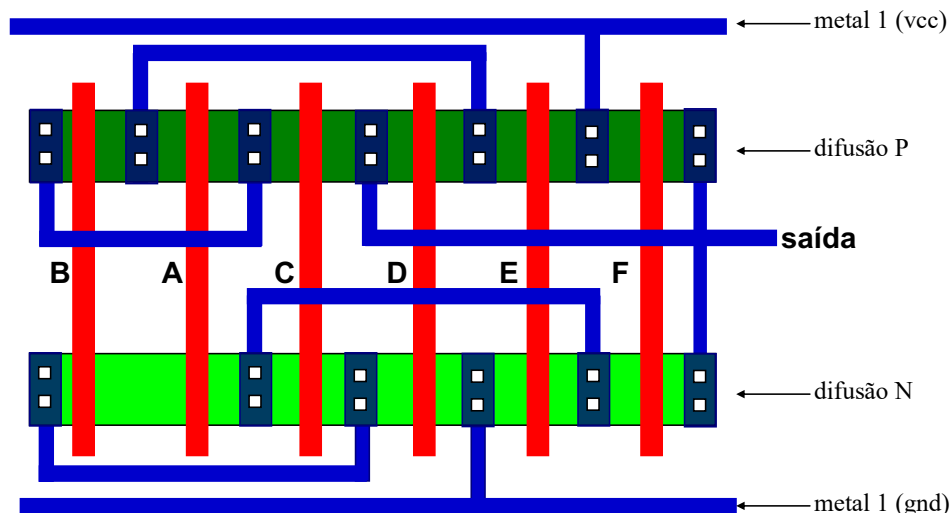


- Determine o diagrama de transistores P do layout ao lado, e usando o princípio da dualidade de conexões série/paralelo determine o diagrama de transistores N.
- Complete o layout para o plano N.
- Qual é a função lógica desta porta complexa (na forma de uma equação lógica) ?
- Número total de transistores, número máximo de transistores em série no plano N e número máximo de transistores em série no plano P.
- Quantos transistores seriam necessários para implementar esta porta lógica complexa, utilizando apenas portas lógicas NAND-NOR-INV. Justifique a resposta apresentando o diagrama lógico de ambas implementações (porta complexa e portas simples).

14) Considere a seguinte equação lógica: $F = ((a.b + c.d) . (e.f + g.(h + i)))$. Pede-se:

- Diagrama lógico
- Diagrama de transistores
- Número de transistores
- Quantos transistores há em série no plano N (conjunto de transistores N) e no plano P?
- Se esta mesma função fosse implementada com portas simples (*nand*, *nor*, *inversor*) quantos transistores seriam necessários? Qual seria a profundidade lógica desta implementação sem portas complexas? Desenhe o circuito lógico equivalente.

15) A figura abaixo representa o layout de uma porta complexa.

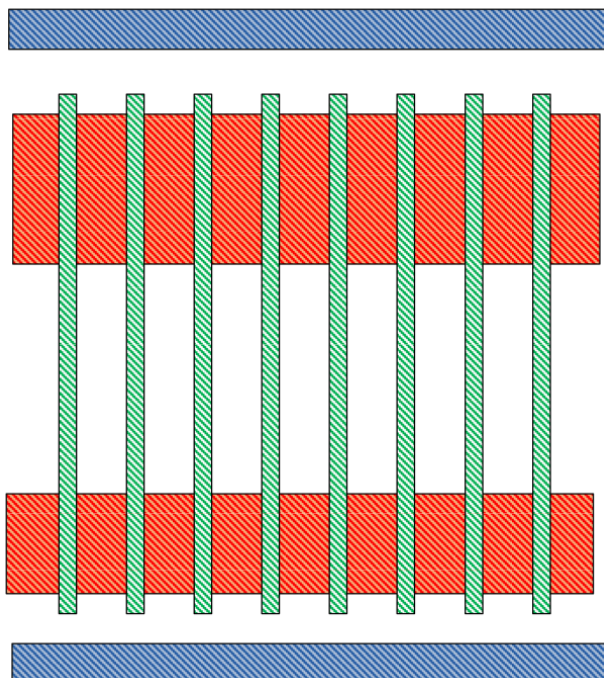


Pede-se:

- Identifique no layout acima em um transistor qualquer os parâmetros W e o L.
- Desenhe o diagrama de transistores (N e P) desta porta lógica
- Qual é a função lógica desta porta? (no formato $F = ((a.b + c.d) . (e.f + g.(h + i)))$)

16) Considere o netlist spice abaixo, o qual representa uma porta lógica CMOS complexa, dual:

MN1	out	e1	3	gnd	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN2	out	e2	3	gnd	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN3	out	e3	3	gnd	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN4	3	e4	4	gnd	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN5	3	e5	4	gnd	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN6	3	e6	4	gnd	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN7	4	e7	gnd	gnd	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN8	out	e8	gnd	gnd	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP9	out	e1	5	vcc	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP10	5	e2	6	vcc	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP11	6	e3	9	vcc	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP12	out	e4	7	vcc	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP13	7	e5	8	vcc	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP14	8	e6	9	vcc	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP15	out	e7	9	vcc	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP16	9	e8	vcc	vcc	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U

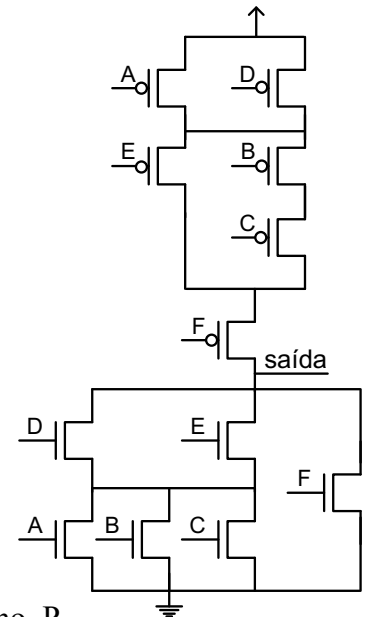
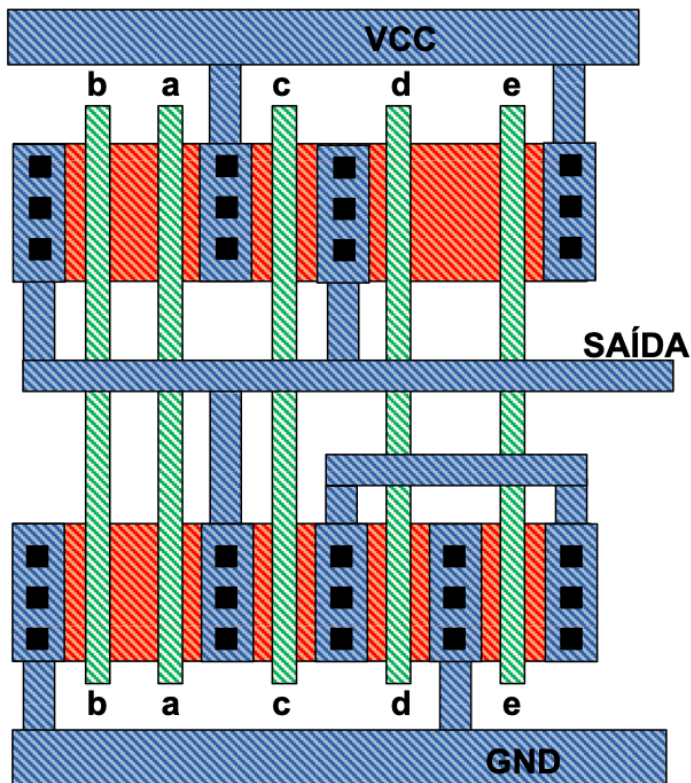


Pede-se:

- Diagrama de transistores (compreensível)
- Diagrama lógico
- Número de transistores total, número máximo de transistores em série no plano N, e número máximo de transistores em série no plano P.
- Complete o *layout* desta porta lógica, sobre o modelo apresentado na figura abaixo (esta célula tem garantidamente caminho dual em ambos os planos), diferenciando os níveis de metal. **Não** alterar a ordem dos transistores.
- Se esta mesma função fosse implementada com portas simples (*nand*, *nor*, *inversor*) quantos transistores seriam necessários? Justifique.

17) Considere o layout abaixo:

- Determine o diagrama de transistores desta porta lógica (fazer desenho compreensível)
- Para o vetor de entrada ABCDE = {11011} determine o valor lógico da saída.
- Esta porta lógica está corretamente projetada? Tanto em caso afirmativo como negativo, justificar a resposta



18) Considere a porta complexa ao lado.

- Qual o valor observado na saída quando $A=1$, $B=0$, $C=0$, $D=0$, $E=1$, $F=0$? Esta porta está corretamente projetada? Em caso negativo, explique o motivo.
- Caso esta porta esteja mal projetada, considere que o plano P represente a função desejada pelo projetista. Como ficaria o diagrama elétrico do plano N?

19) Considere as equações lógicas abaixo:

Pede-se para cada função ao lado:

- Diagrama lógico.
- Diagrama de transistores.
- Layout (stick) de cada função.
- Número de transistores total, número de transistores no plano N/P, número de transistores em série em cada plano.

$$F_1 = \overline{(a.b + c + d)}$$

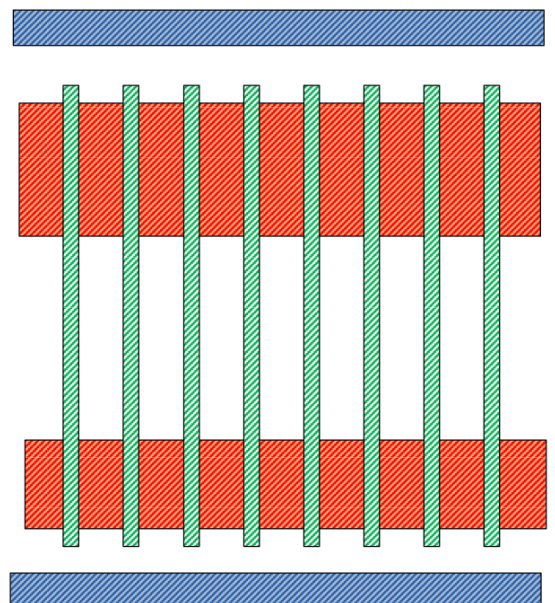
$$F_2 = \overline{(a + b). (c.d.e + f)}$$

$$F_3 = \overline{(a.b) + (c.(d + (e.f)))}$$

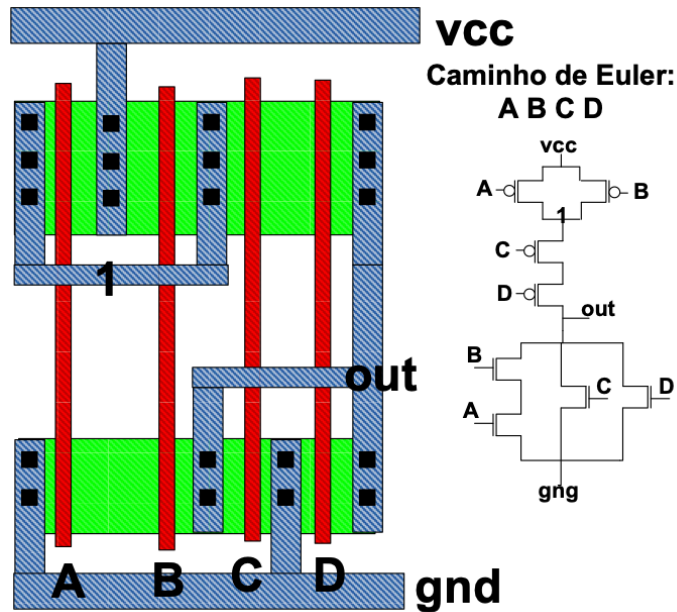
$$F_4 = \overline{a.(b + (c.d) + (e.f))}$$

$$F_5 = \overline{(((a + b).c.) + (d.e.f)).g}$$

Utilizar o template abaixo para o diagrama stick:



Solução de F1: $F_1 = \overline{(a.b + c + d)}$



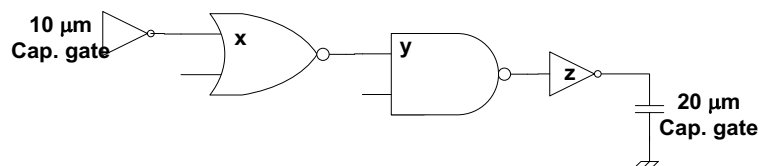
20) Outras funções de portas complexas que podem ser utilizadas como exercícios:

Função
$F = \text{not } ((a+b)*(c*d*e+f*g*(h+i)))$
$F = \text{not } ((a+b)*(c+d+e*(f*g+h*i)))$
$F = \text{not } ((a+b*c*(d+e))*(f+g+h+i))$
$F = \text{not } ((a*b+c*d)*(e*f+g*(h+i)))$
$F = \text{not } ((a*(b+c)+d*e*f)*(g+h+i))$
$F = \text{not } ((a+b+c*d)*(e+f+g*(h+i)))$
$F = \text{not } ((a+b+c*(d+e))*(f+g+h+i))$
$F = \text{not } ((a+b+c+d)*(e+f+g+h*i))$
$F = \text{not } (a*b*(c+(d+e+f)*(g+h+i)))$
$F = \text{not } (a*b*(c+d*e+f*g+h*i))$

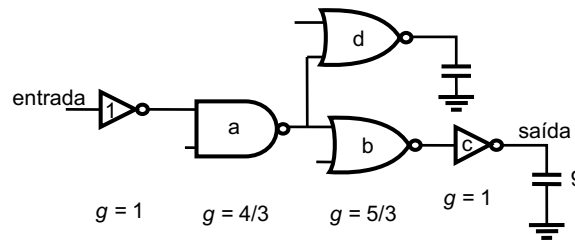
DIMENSIONAMENTO DE PORTAS LÓGICAS

21) Considere a rede multi-estágio abaixo. Ao invés de definirmos as capacitâncias por “C”, define-se pela capacitância equivalente em x microns de gate. Pede-se:

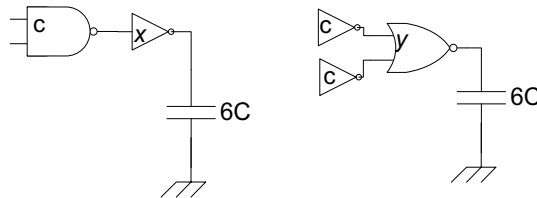
- Atraso mínimo no caminho (em unidades adimensionais de atraso)
- Dimensionamento para atraso mínimo do inversor, nand e nor
- Contribuição do atraso em cada porta, e verifique se o somatório dos atrasos confere com o atraso mínimo no caminho.



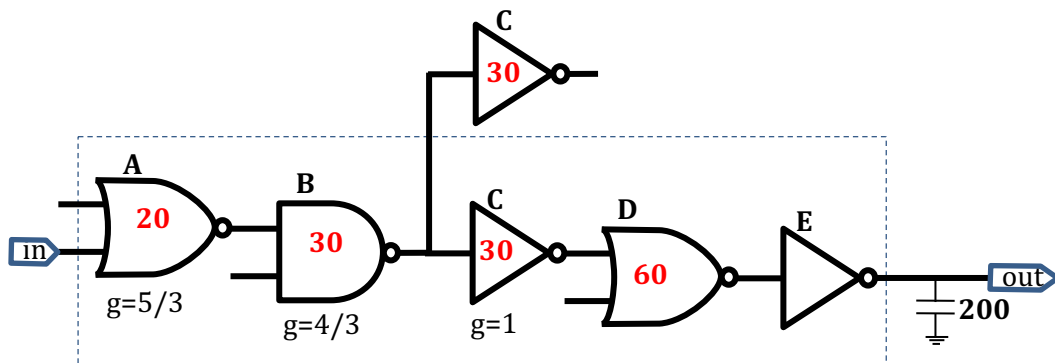
- 22) Dimensione o seguinte circuito (valores de a, b, e c) para obter o menor tempo de propagação da entrada para saída.



- 23) Considere que o caminho mais longo em um dado circuito compreenda 8 portas lógicas. O caminho crítico compreende 8 portas nand-4, todas com fan-out 3. Determine o atraso d (adimensional) desta sequência de portas. Atenção: o fator de branch compreende o produtório de 7 saídas e a relação de carga será igual a 3.
- 24) Considere 2 formas distintas de se implementar uma porta AND-2, com uma relação de carga de 6 entre a entrada e a saída. Determine o “esforço do caminho” para ambas as configurações. Qual das duas configurações é mais rápida? Calcule o tamanho relativo x e y das portas lógicas para que se obtenha o atraso mínimo.

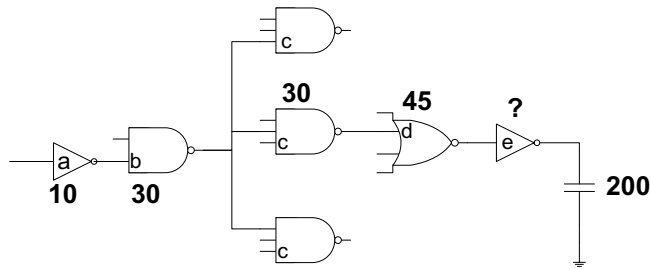


- 25) Considere o caminho lógico abaixo, entre a porta A com entrada igual a **20** unidades de W, e saída conectada a uma carga equivalente a **200** unidades de W. As portas lógicas {A,B,C,D} já estão dimensionadas, com tamanho de {**20, 30, 30, 60**}.



Pede-se:

- Determine o atraso mínimo do caminho.
 - Qual o dimensionamento de cada porta lógica considerando o atraso mínimo?
 - Determine o dimensionamento do inversor E para que o atraso seja igual a **22** unidades de atraso.
- 26) Considere a rede multi-estágio abaixo, onde as capacitâncias estão definidas por x microns de gates ($g_{inv}=1$, $g_{nand2}=4/3$, $g_{nand3}=5/3$, $g_{nor4}=9/3$).



Neste exercício específico, todas as portas lógicas estão dimensionadas, exceto o inversor de saída. Supondo que o projetista determinou que o atraso neste caminho devesse ser **28** unidades de atraso de propagação, determine o dimensionamento do inversor *e*. (lembrando: a fórmula de báscara é $(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})/2a$).

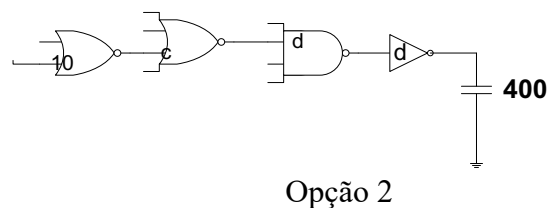
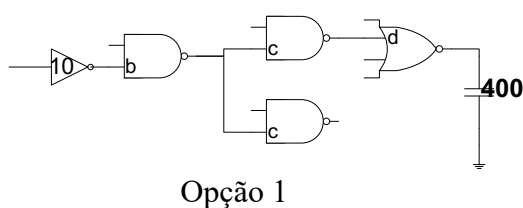
Dica: não usar a equação de atraso mínimo *f*. Montar equações de atraso para cada gate utilizando a equação $d = g \cdot h + p$. Assim teremos $d_A + d_B + d_C + d_D + d_E = 28$, resultando em uma equação de segundo grau.

Havendo duas soluções possíveis, qual seria a adotada? Por quê?

	Dimensionamento (microns)	Atraso da porta
A	10	<determinar>
B	30	<determinar>
C	30	<determinar>
D	45	<determinar>
E	<determinar>	<determinar>
	Atraso total:	28

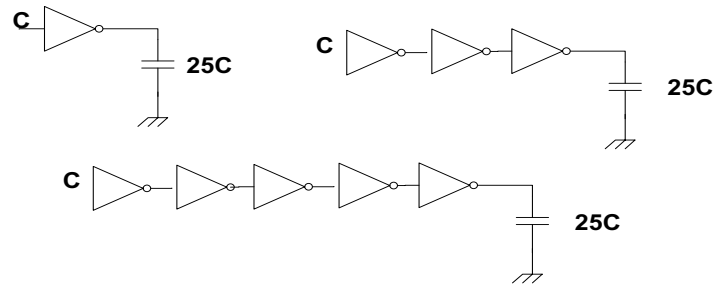
Qual seria o atraso mínimo no caminho, considerando apenas a relação de carga (H), derivação (B), esforço lógico (G), parasitas e número de estágios?

- 27) O projetista, ao utilizar uma ferramenta de síntese, obteve duas soluções distintas para um mesmo circuito, conforme abaixo. Determine a solução que teria menor área (somatório do dimensionamento dos transistores – $10/b/c/d$), e o menor atraso. Justifique as escolhas.

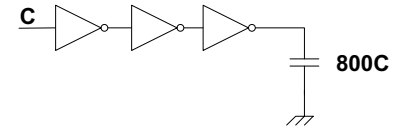


- 28) Considere que um projetista necessita de uma função inversor para carregar uma carga 25 vezes superior à carga de entrada. O projetista considera 3 opções: um único inversor, três inversores em série e cinco inversores em série.

- Para a escolha, calcule a contribuição de cada estágio. O que significa este valor no dimensionamento do transistor?
- Calcule o atraso mínimo do caminho. Através deste cálculo, diga qual a melhor escolha para o projetista.
- Verifique se a fórmula para o número de estágios $N \cong \lceil \log_4 F \rceil$ confere com o resultado obtido.



- 29) Considere que um projetista necessita de uma função inversor para carregar uma carga 800 vezes superior à carga de entrada (isto ocorre, por exemplo, em circuitos de entrada e saída). O projetista considera 4 opções: um único inversor, três inversores em série, cinco inversores em série e sete inversores em série. A figura ao lado ilustra a configuração para 3 inversores em série. Pede-se



- Calcule o atraso mínimo do para as 4 configurações (1-3-5-7). Através deste cálculo, diga qual a melhor escolha para o projetista.
- Para a configuração escolhida, determine o dimensionamento de cada inversor.

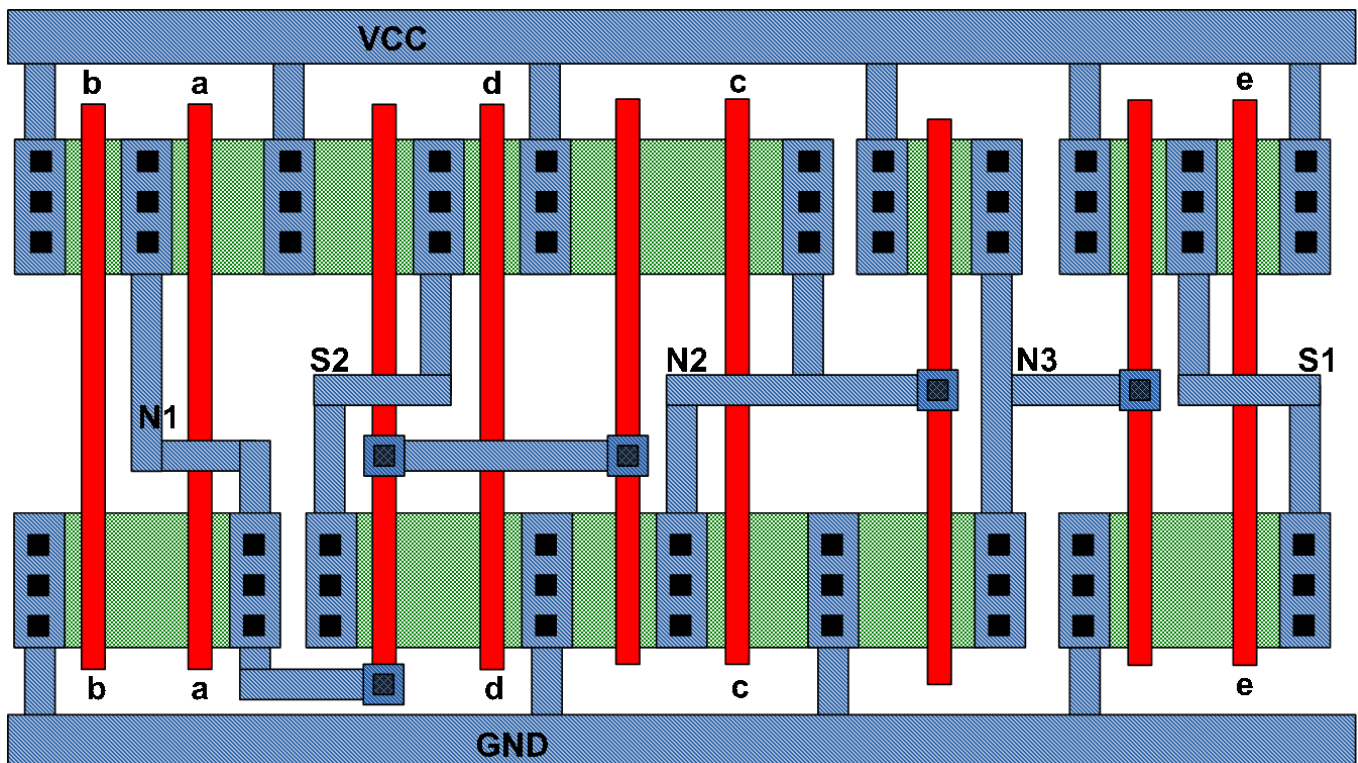
Fórmulas úteis:

- atraso mínimo em um caminho: $\hat{D} = N \cdot F^{\frac{1}{N}} + P$, onde N corresponde ao número de estágios e F o esforço do caminho.
- $F = G \cdot B \cdot H$, onde:
 - G é o esforço lógico do caminho: $G = \prod g_i$
 - B é a influência da derivações no caminho: $B = \prod b_i$, onde $b_i = \frac{C_{total}}{C_{useful}}$
 - H é a relação entre a capacitância de saída pela capacitância de entrada
- a contribuição de cada estágio ao longo de um caminho para se obter o atraso mínimo é dado por: $\hat{f} = g_i \cdot h_i = F^{\frac{1}{N}}$
- de posse da contribuição de cada estágio, dimensiona-se a porta lógica: $C_{in} = \frac{g_i \cdot C_{out}}{\hat{f}}$
- atraso de uma porta: $d = g \cdot h + p$ (onde g é o esforço lógico)

g (esforço Lógico)	1	2	3	4	5	n
Inversor	1					
Nand		4/3	5/3	6/3	7/3	(n+2)/3
Nor		5/3	7/3	9/3	11/3	(2n+1)/3

INTEGRANDO OS TÓPICOS

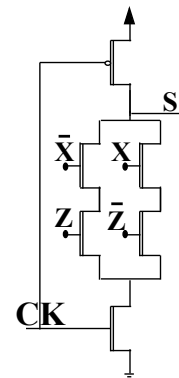
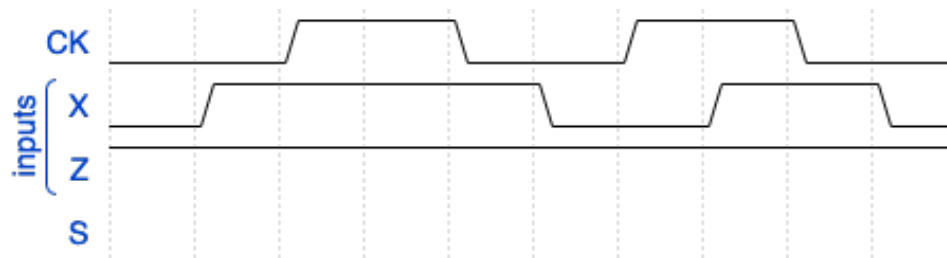
- 30) Considere o layout abaixo, composto por portas lógicas NAND, NOR e INVERSOR, entradas {a,b,c,d,e}, nodos internos {N1,N2,N3} e saídas {S1,S2}. Neste layout não há utilização de METAL2, nem VIAS.
- a. Faça o diagrama de portas lógicas do layout. Para cada porta lógica, indicar as entradas e saídas com o labels do layout ({a,b,c,d,e,N1,N2,N3,S1,S2}).
 - b. A partir do diagrama lógico obtido, indicar qual a parte deste circuito que pode ser **otimizada** com uma **porta complexa**.
 - b.1) Determine o diagrama de transistores desta porta lógica complexa e o correspondente diagrama lógico..
 - b.2) Apresente o diagrama *stick* desta porta lógica, indicando as camadas utilizadas.
 - b.3) Qual o número total de transistores do circuito com e sem a otimização proposta?
 - c. Considerar que o dimensionamento da porta lógica com entradas {a,b} no layout apresentado seja de 2 (2 unidades de dimensionamento) e que a carga de saída seja 5 vezes superior a este dimensionamento.
 - c.1) Determine o atraso mínimo do caminho mais longo (saídas de portas lógicas com labels N1, N2, N3, S1). Considerar na derivação portas de mesmo dimensionamento. ($g_{inv}=1$, $g_{nand2}=4/3$, $g_{nand3}=5/3$, $g_{nor2}=5/3$, $g_{nor3}=7/3$).
 - c.2) Determine o dimensionamento das portas lógicas neste caminho.
 - c.3) Determine o atraso de cada porta lógica.



LÓGICA DINÂMICA

- 31) Explique a operação de portas com lógica dinâmica utilizando o exemplo ao lado.

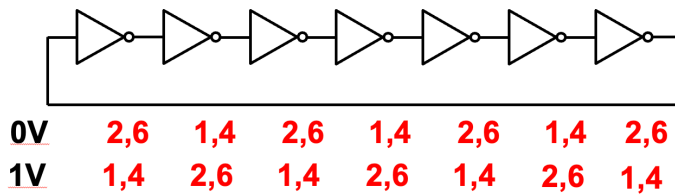
Para o diagrama de tempos apresentados, indicar o valor esperado em 'S', indicando se as transições em 'X' são válidas ou não ('Z' está em '1')



- 32) Explique o que é lógica dinâmica DOMINÓ, e onde a mesma é utilizada.

ALGUMAS SOLUÇÕES

QUESTÃO 4 – Oscilador em anel



$$t_1 = 4 * 2,6 + 3 * 1,4 = 14,6$$

$$t_2 = 4 * 1,4 + 3 * 2,6 = 13,4$$

$$T = 28 \text{ ns} \rightarrow f = 35,71 \text{ MHz}$$

QUESTÃO 5 – Oscilador em anel

t subida - 1 ns

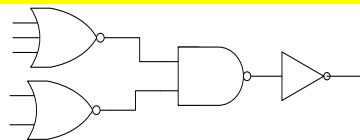
t descia = 0.5 ns

$$\text{PARA SUBIR } 1 + 0,5 + 1 + 0,5 + 1 + 0,5 + 1 = 5,5 \text{ NS}$$

$$\text{PARA DESCER } 0,5 + 1 + 0,5 + 1 + 0,5 + 1 + 0,5 = 5 \text{ NS}$$

$$T_A = 5,5 \quad T_B = 10,5 \quad T_C = 16 \text{ NS etc}$$

QUESTÃO 9 – NOR de 5 entrads



QUESTÃO 10 – Minimização e porta complexa

$$F = AC + BC + BD + \cancel{ACD} + \cancel{AC} + \cancel{BCD} + AD = AC + BC + BD + AD = (A+B).(C+D)$$

A porta lógica terá 8 transistores + 2 inversores → total 10 transistores.

QUESTÃO 11

Porta lógica XNOR, com 10 transistores

Solução: lâminas microel_slides_03 – Lâmina 21 – exercício 1/8

QUESTÃO 12

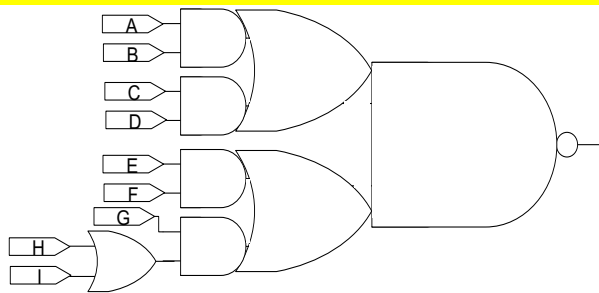
Solução A : lâminas microel_slides_03 – Lâmina 22– exercício 2/8

Solução B : lâminas microel_slides_03 – Lâmina 25– exercício 3/8

QUESTÃO 13

Solução A : lâminas microel_slides_03 – Lâmina 34– exercício 8/8

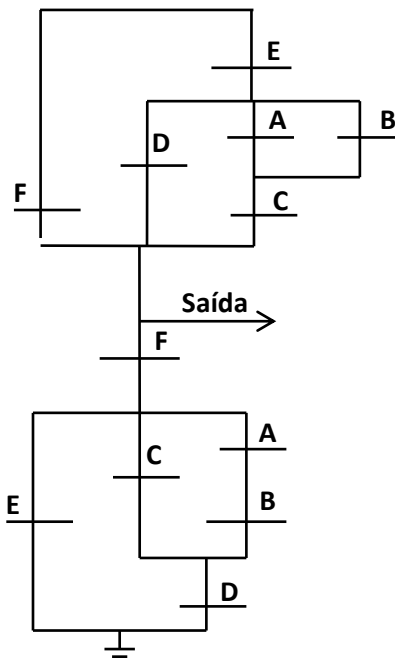
QUESTÃO 14 – porta complexa - $F = \overline{((a.b + c.d) . (e.f + g.(h + i)))}$



18 transistores. Sem portas complexas 34 transistores, com profundidade lógica igual a 4 (sem considerar inversores)

QUESTÃO 15 - Porta complexa

Solução da porta complexa $F = \text{not} ((((AB+C).D)+E).F)$



QUESTÃO 16 - Porta complexa

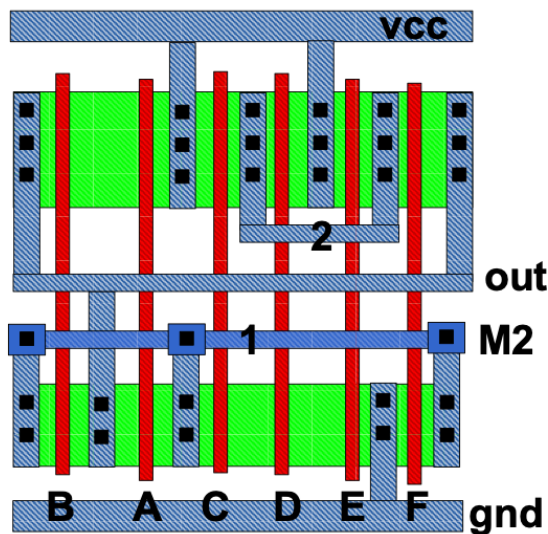
Solução B : lâminas microel_slides_03 – Lâmina 30– exercício 6/8

QUESTÃO 17 - Porta complexa

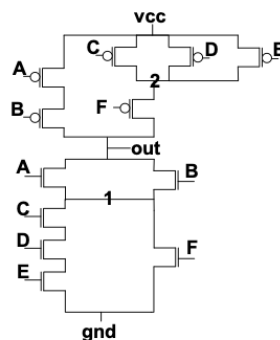
Solução B : lâminas microel_slides_03 – Lâmina 28– exercício 5/8

QUESTÃO 19 - Porta complexas

$$F_2 = \overline{(a + b) \cdot (c.d.e + .f)}$$

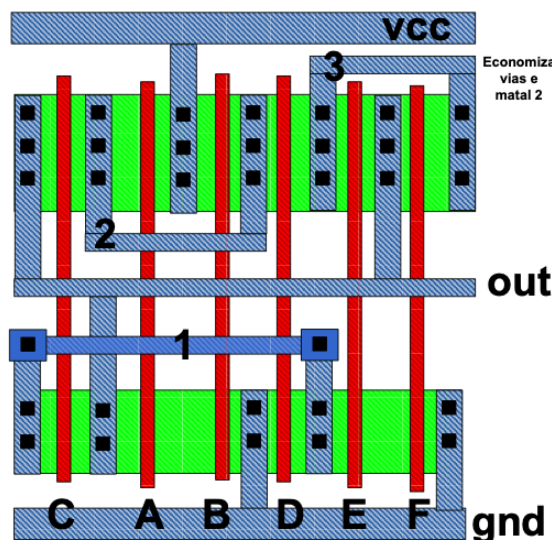


Caminho de Euler:
B A C D E F

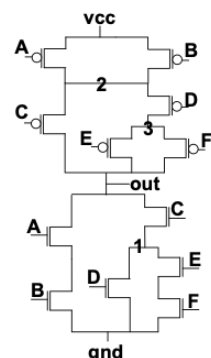


ATENÇÃO AO USO DE METAL 2 E VIA

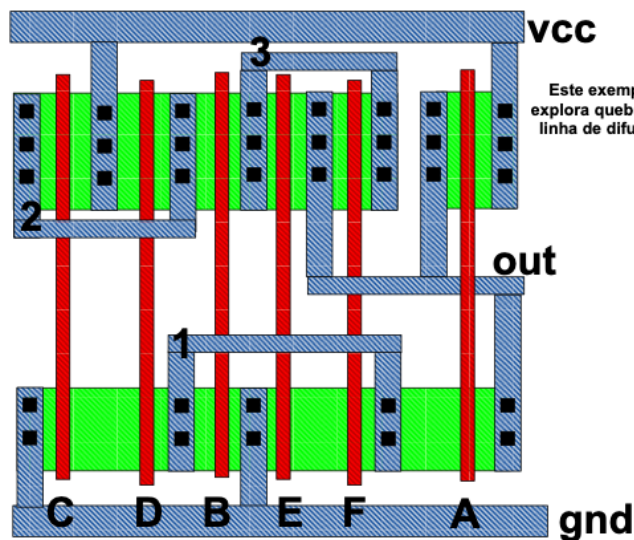
$$F_3 = \overline{(a \cdot b) + (c \cdot (d + (e \cdot f)))}$$



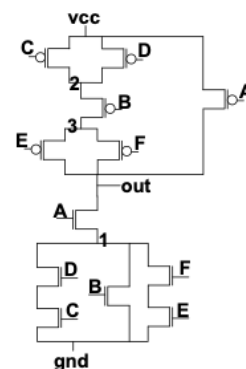
Caminho de Euler:
C A B D E F



$$F_4 = \overline{a \cdot (b + (c \cdot d) + (e \cdot f))}$$



Caminho de Euler
(só no plano N):
C D B E F A



- $c = (4/3) \cdot (2.2,37) / 2,51 = 2,51$
- inversor, conferindo: $1 \cdot 2,51 / 2,51 = 1$ (ok)

- **Tempos ($d = gh + p$)**

- d Inversor: $= 1 \cdot (9/3,57) + 1 = 3,51$
- d Nor $= (5/3) (3,57/2,37) + 2 = 4,51$
- d Nand $= (4/3) (2 \cdot 2,37/2,51) + 2 = 4,51$
- d Inv $= 1 \cdot (2,51/1) + 1 = 3,51$
- **delay total = 16,059 unidades de tempo (ok)**

QUESTÃO 23 – Solução da sequência de 8 nands 4:

$$G = 2^8 = 256 \quad (G \text{ nand4} = 2)$$

$$B = 3^7 = 2187$$

$$H = 3$$

$$P = 8 \cdot 4 = 32$$

$$F = GBH = 1.679.616$$

$$D = 8 \cdot (1.679.616) \exp(1/8) + 32 = 80 \text{ unidades de atraso}$$

QUESTÃO 24 - Dimensionamento ANDs

	G	B	H	F=GBH	P	N	D min	f	y
a	1,33	1,00	6,00	8,00	3,00	2,00	8,66	2,83	2,12
b	1,67	1,00	6,00	10,00	3,00	2,00	9,32	3,16	3,16

QUESTÃO 26 - Dimensionamento de um dado gate

$$dA = 1 \cdot (30/20) + 1 = 4$$

$$dB = (4/3) \cdot (90/30) + 2 = 6$$

$$dC = (5/3) \cdot (45/30) + 3 = 5,5$$

$$dD = (9/3) \cdot (x/45) + 4 = x/15 + 4$$

$$dE = 1 \cdot (200/x) + 1 = 200/x + 1$$

$$4 + 6 + 5,5 + (x/15 + 1) + (200/x + 1) = 28$$

$$x/15 + 200/x - 7,5 = 0$$

$$x^2 - 112,5x + 3000 = 0$$

$$\text{raiz 1} \quad 69,0586885$$

$$\text{raiz 2} \quad 43,4413115$$

A escolha é pela solução 43,44 → menos área de silício

delays	5,603913
	6,896087
	5,5
	6
	4
	28

QUESTÃO 27 – Opções de dimensionamento

	opção 1	opção 2
G	5,333333	10
B	2	1
H	40	40
F (GBH)	426,6667	400
N	4	4
atraso	27,17951	28,88854
f	4,544877	4,472136
d	264,03	89,44
c	77,46	40,00
b	45,45	26,83
in	10,00	10,00
área	396,94	166,28

QUESTÃO 28 – inversores com carga 25 vezes na saída

$$D1 = 1 \cdot 25^1 + 1 = 26$$

$$D2 = 3 \cdot 25^{1/3} + 3 = \mathbf{11,772} \leftarrow \text{três tem o atraso mínimo}$$

$$D2 = 5 \cdot 25^{1/5} + 5 = 14,518$$

Contribuição de cada estágio: $f = 25^{1/3} = 2,92 \rightarrow$ cada inversor deve ser 2,92 vezes maior no estágio seguinte.

$$N = \log_4 F = \log 25 / \log 4 = 2,32 \rightarrow 3 \text{ estágios}$$

QUESTÃO 29 – inversores com carga 800 vezes na saída

Solução da sequência de inversores \rightarrow cinco ESTÁGIOS tem o atraso mínimo

carga	800		5 estágios	
	atraso		f =	3.807308
1	801.00		Inv5	210.12
3	30.85		Inv4	55.19
5	24.04		Inv3	14.50
7	25.19		Inv2	3.81
			Inv1	1.00

Cada inversor deve ser 3,8 vezes maior no estágio seguinte.

QUESTÃO 31 - Lógica dinâmica

